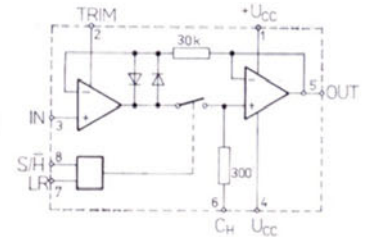
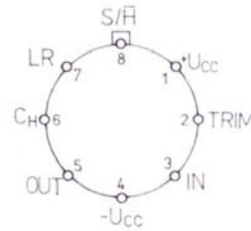


**МОНОЛИТНЫЙ СТРОБИРУЮЩИЙ УСИЛИТЕЛЬ  
ПОВТОРИТЕЛЬНОГО ТИПА, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ  
БЛОКОВ СБОРА АНАЛОГОВЫХ ДАННЫХ И ДЛЯ ОБЩЕГО  
ПРИМЕНЕНИЯ В ПРИБОРАХ**

Предельные значения:

|                   | мин.   | макс.           |      |    |
|-------------------|--------|-----------------|------|----|
| $U_{CC}$          |        | $\pm 18$        | V    |    |
| $U_I$             |        | $U_{CC}$        | V    |    |
| $+U_{7/8}$        |        | +7              | V    |    |
| $-U_{7/8}$        |        | -30             | V    |    |
| $P_{Tot}^1)$      |        | 500             | mW   |    |
| $t_0^2)$          |        | без ограничения |      |    |
| $t_S^3)$          |        | 10              | s    |    |
| $\vartheta_a$     | MAC198 | -55             | +125 | °C |
|                   | MAV398 | 0               | +70  | °C |
| $\vartheta_{stg}$ |        | -55             | +155 | °C |

- 1) При  $\vartheta_a \geq 70^\circ\text{C}$  линейно понизить  $P_{Tot}$  на 6,5 мВт/К.  
2) Продолжительность короткого замыкания на выходе.  
3) Продолжительность короткого замыкания запоминающего конденсатора.



Соединение выводов (вид сверху)

- |   |           |                                  |
|---|-----------|----------------------------------|
| 1 | $+U_{CC}$ | положительное напряжение питания |
| 2 | TRIM      | компенсация входной асимметрии   |
| 3 | IN        | напряжения аналогового вход      |
| 4 | $-U_{CC}$ | отрицательное напряжение питания |
| 5 | OUT       | выход                            |
| 6 | $C_H$     | запоминающий конденсатор         |
| 7 | LR        | логический опорный вход          |
| 8 | S/H       | логический вход                  |

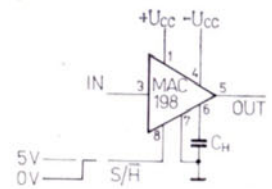
КОРПУС: IO-6/1

Характеристические данные:

|  | MAC198       |            | MAV398           |            |                         |
|--|--------------|------------|------------------|------------|-------------------------|
| <b>Основные значения:</b>  |              |            |                  |            |                         |
| $\vartheta_a = 25^\circ\text{C}$ , $U_{CC} = \pm 15\text{ V}$ , $U_{IL} = 2,5\text{ V}$ , $U_{ILR} = 0\text{ V}$ , $R_L = 10\text{ k}\Omega$ , не приводится ли иначе. |              |            |                  |            |                         |
| Процесс стробирования:   |              |            |                  |            |                         |
| <b>Входное остаточное напряжение</b>   |              | ном. знач. | мин.-макс. знач. | ном. знач. | мин.-макс. знач.        |
| $U_{CC} = \pm 5\text{ V} \dots \pm 18\text{ V}$  | $U_{IO}$     | 1,0        | $\leq 3,0$       | 2,0        | $\leq 7,0$ mV           |
| <b>Входной ток покоя</b>   |              |            |                  |            |                         |
| $U_{CC} = \pm 5\text{ V} \dots \pm 18\text{ V}$  | $I_{IB}$     | 5,0        | $\leq 25$        | 10         | $\leq 50$ nA            |
| <b>Ошибка усиления</b>   |              |            |                  |            |                         |
| $U_I = \pm 11,5\text{ V}$  | $E_A$        | 0,002      | $\leq 0,005$     | 0,004      | $\leq 0,01$ %           |
| <b>Проникновение входного сигнала на выход — процесс запоминания</b>   |              |            |                  |            |                         |
| $f = 1\text{ kHz}$ , $U_I = \pm 11,5\text{ V}$ , $C_H = 10\text{ nF}$  | $P$          | -96        | $\geq -86$       | -90        | $\geq -80$ dB           |
| <b>Выходное сопротивление (процесс запоминания)</b>  |              |            |                  |            |                         |
| $U_{CC} = \pm 5\text{ V} \dots \pm 18\text{ V}$  | $R_O$        | 0,5        | $\leq 2,0$       | 0,5        | $\leq 4,0$ $\Omega$     |
| <b>Скачкообразное напряжение размыкания</b>  |              |            |                  |            |                         |
| $U_I = 0\text{ V}$ , $C_H = 10\text{ nF}$ , $U_{IL} = 5\text{ V}$  | $\Delta U_O$ | 0,5        | $\leq 2,0$       | 1,0        | $\leq 2,5$ mV           |
| <b>Ток питания</b>   |              |            |                  |            |                         |
| $U_{CC} = \pm 5\text{ V} \dots \pm 18\text{ V}$  | $I_{CC}$     | 4,5        | $\leq 5,5$       | 4,5        | $\leq 6,5$ mA           |
| <b>Входной ток логических входов</b>   |              |            |                  |            |                         |
|  | $I_{IL}$     | 2,0        | $\leq 10$        | 2,0        | $\leq 10$ $\mu\text{A}$ |
| <b>Проникновение тока небаланса в запоминающий конденсатор<sup>2)</sup> — процесс запоминания</b>  |              |            |                  |            |                         |
| $U_{CC} = \pm 5\text{ V} \dots \pm 18\text{ V}$  | $I_{CO}$     | 30         | $\leq 100$       | 30         | $\leq 200$ pA           |
| <b>Подавление воздействия изменений <math>U_{CC}</math> на <math>U_{IO}</math></b>   |              |            |                  |            |                         |
| $U_{CC} = \pm 5\text{ V} \dots \pm 18\text{ V}$  | SVR          | 110        | $\geq 80$        | 110        | $\geq 80$ dB            |
| <b>Логический уровень дифференциации (пороговое логическое напряжение)</b>   |              |            |                  |            |                         |
|  | $U_{IL}$     | 1,4        | 0,8...2,4        | 1,4        | 0,8...2,4 V             |

$\vartheta_a \text{ min} \leq \vartheta_a \leq \vartheta_a \text{ max}$ ,  $U_{CC} = \pm 15\text{ V}$ ,  $R_L = 10\text{ k}\Omega$ ,  $U_{IL} = 2,5\text{ V}$ ,  $U_{ILR} = 0\text{ V}$   
Процесс стробирования:

|   |          | мин.-макс. знач. | мин.-макс. знач. |          |
|---|----------|------------------|------------------|----------|
| <b>Входное остаточное напряжение</b>                |          |                  |                  |          |
| $U_{CC} = \pm 5\text{ V} \dots \pm 18\text{ V}$     | $U_{IO}$ | $\leq 5,0$       | $\leq 10$        | mV       |
| <b>Входной ток покоя</b>                            |          |                  |                  |          |
| $U_{CC} = \pm 5\text{ V} \dots \pm 18\text{ V}$     | $I_{IB}$ | $\leq 75$        | $\leq 100$       | nA       |
| <b>Ошибка усиления</b>                              |          |                  |                  |          |
| $U_I = \pm 11,5\text{ V}$                           | $E_A$    | $\leq 0,02$      | $\leq 0,02$      | %        |
| <b>Выходное сопротивление (процесс запоминания)</b> |          |                  |                  |          |
|   | $R_O$    | $\leq 4$         | $\leq 6$         | $\Omega$ |



Типичное эксплуатационное соединение

Справочные данные:

$\vartheta_a = 25^\circ\text{C}$ ,  $U_{CC} = \pm 15\text{ V}$ ,  $C_H = 0,01\text{ }\mu\text{F}$ ,  $R_L = 10\text{ k}\Omega$ ,  $U_{IL} = 2,5\text{ V}$ ,  $U_{ILR} = 0\text{ V}$ , не приводится ли иначе.

Стробирование:

Входное сопротивление  $U_I = \pm 11,5\text{ V}$   $R_I$   $10^{10}$   $\Omega$

Время крепления на точность повторения  $0,1\text{ }\%$

$C_H = 1000\text{ pF}$ ,  $\Delta U_O = 10\text{ V}$   $t_{akv}$   $4\text{ }\mu\text{s}$

$C_H = 10\text{ nF}$ ,  $\Delta U_O = 10\text{ V}$   $t_{akv}$   $20\text{ }\mu\text{s}$

Зарядный ток запоминающего конденсатора  $U_I - U_O = 2\text{ V}$   $I_C$   $5\text{ mA}$

1) Процесс запоминания чувствителен к паразитной связи между входными логическими сигналами и запоминающим конденсатором (например ёмкость 1 pF вызывает нежелательный скачок на 0,5 mV при изменении логического напряжения 5 V и при значении запоминающего конденсатора 0,01  $\mu\text{F}$ ).

Размер нежелательного изменения находится в обратной пропорциональности с размером ёмкости памяти.

2) Остаточный ток измеряется при температуре перехода  $25^\circ\text{C}$ , причем он гарантирован во всем диапазоне входных напряжений  $-11,5\text{ V} \leq U_I \leq +11,5\text{ V}$ .